



一种动态受控电弧离子镀弧源

文献类型: 专利

作者 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 杨英, 赵彦辉, 杜昊 and 闻立时

发表日期 2009-02-04

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及薄膜制备领域,具体地说是一种利用动态磁场控制弧斑运动的电 弧离子镀弧源。所述动态受控电弧离子镀弧源设有动态控制磁场发生装置、靶材、靶材底座,靶材安装于靶材底座上,动态控制磁场发生装置为主控磁场发生装置 和辅助磁场发生装置构成,主控磁场发生装置放置于靶材后面,和靶材同轴放置, 辅助磁场发生装置套在 主控磁场发生装置周围。本发明通过两组磁场发生装置配 合使用,在靶面上形成动态分布的拱形磁场,达到改善弧斑的放电形式和工作稳 定性,控制弧斑的运动轨迹,提高靶材刻蚀均匀性和靶材利用率,减少靶材大颗 粒的发射,用以制备高质量的薄膜的目的。

公开日期 2009-02-04

语种 中文

专利申请号 CN101358328

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66738]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 杨英, 赵彦辉, 杜昊 and 闻立时. 一种动态受控电弧离子镀弧源. 2009-02-04. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

93

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

